

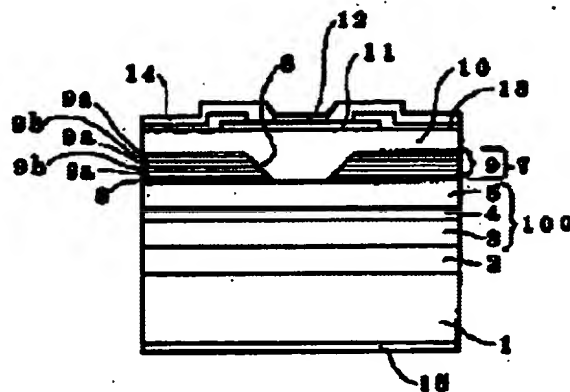
SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Patent number: JP5243667
Publication date: 1993-09-21
Inventor: MIYAKE TERUAKI; others: 03
Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD
Classification:
- International: H01S3/18
- european:
Application number: JP19920041204 19920227
Priority number(s):

Abstract of JP5243667

PURPOSE: To provide a GaAlAs series semiconductor laser having a current blocking layer which has an excellent current blocking effect.

CONSTITUTION: A current blocking layer 7 having a plurality of Ga_{1-x}Al_xAs layers ($0.2 < x < 0.8$, layer thickness: 0.1 μm or less) 9b is formed on a double hetero structure 100. The layer 7 is formed with a recess 6, and a current injection layer 10 is formed in the recess 6.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-243667

(43)公開日 平成5年(1993)9月21日

(51)Int.Cl.⁴

H 0 1 S 3/18

識別記号

庁内整理番号

9170-4M

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平4-41204

(22)出願日 平成4年(1992)2月27日

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

(72)発明者 三宅 輝明

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋
電機株式会社内

(72)発明者 茂木 晃

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋
電機株式会社内

(72)発明者 古沢 浩太郎

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋
電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 西野 卓爾

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体レーザ装置

(57)【要約】

【目的】 電流阻止効果の優れた電流阻止層をもつGa
AlAs系半導体レーザ装置を提供することを目的とす
る。

【構成】 ダブルヘテロ構造100上に複数のGa
AlAs層(0.2<x<0.8、層厚:0.1μ
m以下)9bを含む電流阻止層7を形成する。この電流
阻止層7は凹部6が形成されており、該凹部6内に電流
注入層10が形成される。

